（三）　シリコン貫通電極を作るためのエッチングに用いるために設計した装置であって、次の全てに該当するもの（カ、ヨ、タ、ア（一）又はア（二）に該当するものを除く。）

１　シリコンのエッチング速度が一分につき七マイクロメートルを超えるもの

２　ウエハー内のエッチングの深さの不均一性が二パーセント以下のもの

３　シリコン貫通電極のアスペクト比が一〇以上のもの

サ　極端紫外パターンシェイピング用に設計した装置（カ（一）、ヨ又はア（一）に該当するものを除く。）　（新設）

キ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの　（新設）

（一）　タングステンの膜を物理的気相成長法により成膜する装置であって、イオンフラックス誘導用の電磁石を有し、アスペクト比を三以上の形状に対して成膜するために特別に設計したもの

（二）　モリブデン若しくはルテニウム又はモリブデンとルテニウムを組み合わせた膜を原子層堆積法により成膜するように設計又は改造した装置であって、次の全てに該当するもの（ネに該当するものを除く。）

１　七五度を超える温度で動作するように設計又は改造した金属前駆体の供給源を有するもの

２　四キロパスカル以上の圧力で水素を含む還元剤を使用するプロセスチャンバーを有するもの

（三）　プラズマ又はラジカルを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置であって、基板の温度を五〇〇度未満に維持しながら、誘電体膜を単一の装置上で紫外線による硬化を行うもののうち、次の全てに該当する誘電体膜を成膜できるもの

１　六ナノメートル超二〇ナノメートル未満の厚さの金属形状であって、二四ナノメートル未満のピッチを有し、かつ、一・八以上のアスペクト比を有するもの

２　三・〇未満の比誘電率を有するもの

（四）　炭素材料を化学的気相成長法により成膜するように設計した装置であって、密度が一立方センチメートル当たり一・六グラムを超える材料を用いたもの（ヰに該当するものを除く。）

（五）　二種類以上の金属前駆体を直接液体注入する成膜装置であって、単一の成膜用のチャンバー内に、幅に対する深さの比率が五〇倍を超える形状に、比誘電率が三五を超える等方的誘電体膜を成膜するように設計又は改造したもの

ユ　三〇〇ミリメートルウエハー用に設計したアニール装置であって、ウエハーを一、〇〇〇度を超える温度で、二ミリ秒未満の持続時間で加熱できるように設計したもの　（新設）

メ　超臨界二酸化炭素又は昇華乾燥を用いるように設計した枚葉式のウエハー洗浄装置　（新設）

ミ　直径三〇〇ミリメートル以上のウエハーを受け入れるように設計又は改造したパターン付きウエハー欠陥測定装置又はパターン付きウエハー欠陥検査装置であって、次の全てに該当するもの　（新設）

（一）　二一ナノメートル以下の大きさの欠陥を検出するように設計又は改造したもの

（二）　次のいずれかを有するもの

１　波長が四〇〇ナノメートル未満の光源

２　分解能が一・六五ナノメートル以下の電子ビーム源